

*Письма в ЖЭТФ, том 11, стр. 421 – 424*

*20 апреля 1970 г.*

## "СУПЕРГЕТЕРОДИННОЕ" УСИЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ

*Е.Б.Гуллев, П.Е.Зильберман*

В настоящей работе мы рассмотрим эффект распределенного "супергетеродинного" усиления звука дрейфовым потоком электронов в полупроводнике в присутствие интенсивной звуковой волны накачки, играющей роль гетеродина. Будет показано, что информация сигнала (несущая частота  $\omega_c$ ) при немодулированном взаимодействии его с гетеродином (частота  $\omega_r$ ) преобразуется непрерывно по длине кристалла к другой частоте (промежуточной,  $\omega_{\Pi}$ ) и обратно. В результате этого свойственный промежуточной частоте инкремент роста, если он достаточно велик, переносится и на частоту сигнала.

Как известно, [1–3] условие синхронизма выделяет ряд волн наиболее сильно взаимодействующих через накачку (волну  $\omega_{\Gamma}$ ). Например, это могут быть волны с частотами  $\omega_c = \omega_p = \omega_{\Gamma} - \omega_c$ ,  $\omega'_p = \omega_{\Gamma} + \omega_c$  и другими комбинационными частотами вида  $n\omega_{\Gamma} \pm \omega_c$  ( $n$  – целое число). Существенно, что мы, таким образом, имеем систему связанных монохроматических волн. Каждая такая монохроматическая волна не является более собственной волной в кристалле. Собственная волна представляет собой, вообще говоря, смесь монохроматических волн всех взаимодействующих частот. Она характеризуется определенным образом согласованными фазовыми скоростями отдельных монохроматических компонент и единым инкрементом роста. В общем случае этот инкремент описывает два эффекта – параметрическое [1–3] и обычное линейное усиление [4]. Собственную волну, которая в отсутствие накачки  $\omega_{\Gamma}$  переходит в волну с частотой  $\omega_p$ , будем, для кратности, называть "собственной волной типа  $\omega_p$ " (и аналогично для волн типа  $\omega_c$ ,  $\omega'_p$  и т. д.).

Пусть на входе кристалла возбуждается упругое колебания частоты  $\omega_c$ . Тогда из-за параметрического взаимодействия с накачкой  $\omega_{\Gamma}$  в кристалле возбудителя суперпозиция различных собственных волн. Предположим далее, что инкремент роста из таких волн (например типа  $\omega_p$ ) гораздо больше, чем других. Легче всего это условие реализуется вдали от параметрического резонанса ( $\omega_c \gg \omega_p$  или  $\omega_c \ll \omega_p$ ). Тогда может оказаться, что на выходе кристалла примесь частоты  $\omega_c$  в собственной волне типа  $\omega_p$  по своей амплитуде будет намного превосходить амплитуду колебаний на частоте  $\omega_c$  в других собственных типах волн. В этом случае усиление звука частоты  $\omega_c$  будет определяться максимальным инкрементом роста  $a_p$  волны типа  $\omega_p$ .

Описываемый механизм усиления может не иметь ничего общего с обычным параметрическим усилением. Действительно, рассмотрим случай, когда накачка достаточно интенсивна, чтобы обеспечить эффективную связь колебаний на частотах  $\omega_c$  и  $\omega_p$ , но в тоже время достаточно слаба, чтобы можно было пренебречь эффектом параметрического усиления – влиянием накачки на инкремент роста  $a_p$ . Что такая ситуация на самом деле возможна, следует из расчета и будет показано далее. Тогда усиление волн происходит почти исключительно из-за сверхзвукового дрейфа электронов [4]. Действие же волны  $\omega_{\Gamma}$  сводится к переносу большого линейного усиления, свойственного частоте  $\omega_p$  на частоту сигнала  $\omega_c$ . Следовательно, волна  $\omega_{\Gamma}$ , в данном случае, действует именно как волна гетеродина.

Теория такого усиления может быть построена подобно теории параметрического усиления звука звуком в полупроводниках (см., например, [3]). Рассмотрим, как и в [3], для простоты взаимодействие трех волн одной поляризации с частотами  $\omega_c$ ,  $\omega_{\Gamma}$  и  $\omega_p = \omega_{\Gamma} - \omega_c$  и волновыми векторами  $q_c$ ,  $q_{\Gamma}$  и  $q_p = q_{\Gamma} - q_c$ . Все три волны считаем достаточно слабыми в смысле применимости к ним методики итераций по амплитуде. Амплитуду гетеродина полагаем гораздо большей амплитуды сигнала и промежуточной частоты и на этом основании пренебрегаем обратным влиянием последних на гетеродин. Кроме того, рассматриваем лишь случай, когда  $\omega_c \sim \omega_{\Gamma} \gg \omega_p$  и максимальное линейное усиление соответствует частоте  $\omega_p$ . Это позволяет пренебречь усилением гетеродина, что упрощает расчет. Тогда получаем систему двух связанных линейных дифференциальных уравнений первого порядка для комплексных амплитуд сигнала  $u_c(x)$  и промежуточной частоты  $u_p(x)$ , как функций пространственной координаты  $x$ . Отыскиваем решение этих уравнений, удовлетворяющее граничному условию:  $u_c(0) = U_0$ ,  $u_p(0) = 0$ . Затем вычисля-

ем коэффициент усиления в дБ/см

$$\gamma = \frac{20}{4} \lg \left| \frac{u_C(L)}{u_C(0)} \right|, \text{ где } L - \text{длина кристалла.}$$

В результате получаем

$$\gamma = 8,6 \left[ a_{\Pi} + \frac{1}{L} \ln \left| \frac{|g|^2 K_{\Pi} K_{C}^* - e^{-(a_{\Pi} - a_C)L}}{1 - |g|^2 K_{\Pi} K_{C}^*} \right| \right], \quad (1)$$

где  $a_C$  и  $a_{\Pi}$  — инкременты роста собственных волн соответственно типа  $\omega_C$  и  $\omega_{\Pi}$ ,  $g = \frac{\delta N}{N_0}$ ,  $\delta N$  — комплексная амплитуда колебаний концентрации электронов в волне гетеродина,  $N_0$  — равновесная концентрация электронов.

Величины  $K_{\Pi}$  и  $K_{C}^*$  суть коэффициенты распределения:  $i g K_{\Pi} = \left( \frac{u_C}{u_{\Pi}} \right)$  в собственной волне типа  $\omega_{\Pi}$ ,  $-i g^* K_{C}^* = \left( \frac{u_{\Pi}}{u_C} \right)$  в собственной волне типа  $\omega_C$ .

Если интенсивность волны гетеродина  $\sim |g|^2 \rightarrow 0$ , то из (1) получаем  $\gamma = 8,6 \times a_C$  дБ/см. Иными словами, сигнал усиливается в соответствии с линейной теорией [4].

При

$$|g|^2 \sim |g|_{kp}^2 = \frac{1}{|K_{\Pi} K_{C}^*|} e^{-(a_{\Pi} - a_C)L} \quad (2)$$

происходит переход на супергетеродинный режим усиления (считается, что  $a_{\Pi} \gg a_C$  и  $a_{\Pi}L \gg 1$ ). Из (2) видно, что при больших  $a_{\Pi}L$  параметр  $|g|_{kp}^2$  экспоненциально мал. Поскольку параметрическая добавка в усиление вдали от резонанса ( $\omega_C \gg \omega_{\Pi}$ ) пропорциональна  $|g|^2$ , то она действительно может быть мала по сравнению с  $a_{\Pi}$ . Тогда  $a_{\Pi}$  есть практически инкремент нарастания [4]. Возьмем для примера

$$q_{\Pi} r_D = 1, \quad \omega_{\Pi} r_M \left( \frac{v_o}{v_s} \right) - 1 \sim 0,1,$$

$\omega_{\Pi}/\omega_C \sim 0,3$  и  $q_{\Pi} L \sim 10^4$ , где  $r_D$  — радиус экранирования,  $r_M$  — максвелловское время релаксации,  $v_o$  — скорость дрейфа,  $v_s$  — скорость звука ( $v_o > v_s$ ). С этими параметрами по формуле (2) получаем  $|g|_{kp} \sim 10^{-2}$ . При  $|g| > |g|_{kp}$  из (1)  $\gamma = 8,6 \cdot a_{\Pi}$  дБ/см, т. е. на частоту сигнала действительно переносится максимальный инкремент роста. Такое супергетеродинное усиление, по-видимому, впервые наблюдалось на опыте в работе [5]<sup>1)</sup>, хотя интерпретация, предлагаемая авторами [5] нуждается в уточнении. Кроме того, рассматриваемый нами случай, видимо, интереснее с практической точки зрения, поскольку в нем большое усиление переносится на высокую частоту.

Заметим, что принцип распределенного супергетеродинного усиления применим и к другим типам волн (например, электромагнитным), распространяю-

<sup>1)</sup> Мы благодарны В.К.Комарю и Б.Л.Тиману за предоставление возможность ознакомиться с их работой до ее опубликования.

щимся в нелинейной среде, которая способна к селективному усилению некоторых частот.

Авторы благодарны В.Л.Бонч-Бруевичу и участникам руководимого им семинара за обсуждение работы.

Институт радиоэлектроники  
Академии наук СССР

Поступила в редакцию  
20 февраля 1970 г.  
После переработки  
18 марта 1970 г.

### Литература

- [1] Е.А.Заболотская, С.И.Солуян, Р.В.Хохлов. Акуст. Журнал, 12, 435, 1966.
- [2] S.Zemon, J.Zucker, J.H.Wasko, E.M.Conwell, A.K.Ganguly. Appl. Phys. Lett., 12, 378, 1968.
- [3] Yu.V.Gulayev, P.E.Zilberman. Phys. Lett., 30A, 378, 1969.
- [4] A.R.Hutson, J.H.McFee, D.L.White. Phys. Rev. Lett., 7, 237, 1961.
- [5] В.К.Комарь, Б.Л.Тиман. ФТТ, 12, № 1, 1970.